

Title (en)
METHOD FOR DEPOSITING AN ELECTRIC CONDUCTOR METAL ON AT LEAST ONE PORTION OF THE INNER SURFACE OF AN INTERNAL CAVITY OF A WAVEGUIDE

Title (de)
VERFAHREN ZUR AUFBRINGUNG EINES ELEKTRISCH LEITENDEN METALLS AUF MINDESTENS EINEN TEIL EINER INNENFLÄCHE EINES INTERNEN HOHLRAUMS EINES WELLENLEITERS

Title (fr)
PROCÉDÉ DE DÉPÔT D'UN MÉTAL CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE SUR AU MOINS UNE PARTIE DE LA SURFACE INTERNE D'UNE CAVITÉ INTERNE D'UN GUIDE D'ONDES

Publication
EP 3771750 A1 20210203 (FR)

Application
EP 20188644 A 20200730

Priority
FR 1908910 A 20190802

Abstract (en)
[origin: US2021036397A1] A method for depositing an electrically conductive metal onto at least one portion of the inner surface (3) of an internal cavity (2) of a waveguide (1) includes: preparing a suspension containing at least one liquid and at least one precursor of the electrically conductive metal in suspension in said at least one liquid; coating at least one portion of the inner surface (3) of the internal cavity (2) of the waveguide (1) with the suspension, and heat-treating at least said portion of the inner surface (3) of the internal cavity (2) of the waveguide (1) coated with the suspension. A method for manufacturing a metallized waveguide can implement this deposition method.

Abstract (fr)
L'invention concerne un procédé de dépôt d'un métal conducteur électrique sur au moins une partie de la surface interne (3) d'une cavité interne (2) d'un guide d'ondes (1). Ce procédé consiste en ce que :- on prépare une suspension qui contient au moins un liquide et au moins un précurseur du métal conducteur électrique en suspension dans ledit au moins un liquide ; - on enduit au moins une partie de la surface interne (3) de la cavité interne (2) du guide d'ondes (1) avec la suspension ; - on traite thermiquement au moins ladite partie de la surface interne (3) de la cavité interne (2) du guide d'ondes (1) enduite avec la suspension. L'invention concerne, encore, un procédé de fabrication d'un guide d'ondes métallisé mettant en œuvre ce procédé de dépôt.

IPC 8 full level
C23C 24/08 (2006.01); **C23C 26/00** (2006.01); **G02B 6/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)
B05D 3/0254 (2013.01 - US); **B05D 5/12** (2013.01 - US); **B05D 7/22** (2013.01 - US); **B05D 7/222** (2013.01 - US); **C23C 18/02** (2013.01 - US); **C23C 24/08** (2013.01 - EP US); **C23C 26/00** (2013.01 - EP US); **H01P 3/12** (2013.01 - US); **H01P 11/002** (2013.01 - EP US); **B05D 2202/35** (2013.01 - US); **B05D 2254/04** (2013.01 - US)

Citation (search report)

- [XA] EP 0691554 A1 19960110 - COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE [FR]
- [XA] EP 0344478 A2 19891206 - UNIV RAMOT [IL]
- [XA] US 2005265677 A1 20051201 - HONGO AKIHITO [JP], et al
- [A] US 2006222762 A1 20061005 - MCEVOY KEVIN P [US], et al
- [A] WO 2013030064 A1 20130307 - SWEREA IVF AB [SE], et al

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 3771750 A1 20210203; **EP 3771750 B1 20240327**; ES 2982125 T3 20241014; FR 3099491 A1 20210205; FR 3099491 B1 20220114; JP 2021055181 A 20210408; PL 3771750 T3 20240729; US 11404761 B2 20220802; US 2021036397 A1 20210204

DOCDB simple family (application)
EP 20188644 A 20200730; ES 20188644 T 20200730; FR 1908910 A 20190802; JP 2020130910 A 20200731; PL 20188644 T 20200730; US 202016944657 A 20200731